SMD-51248

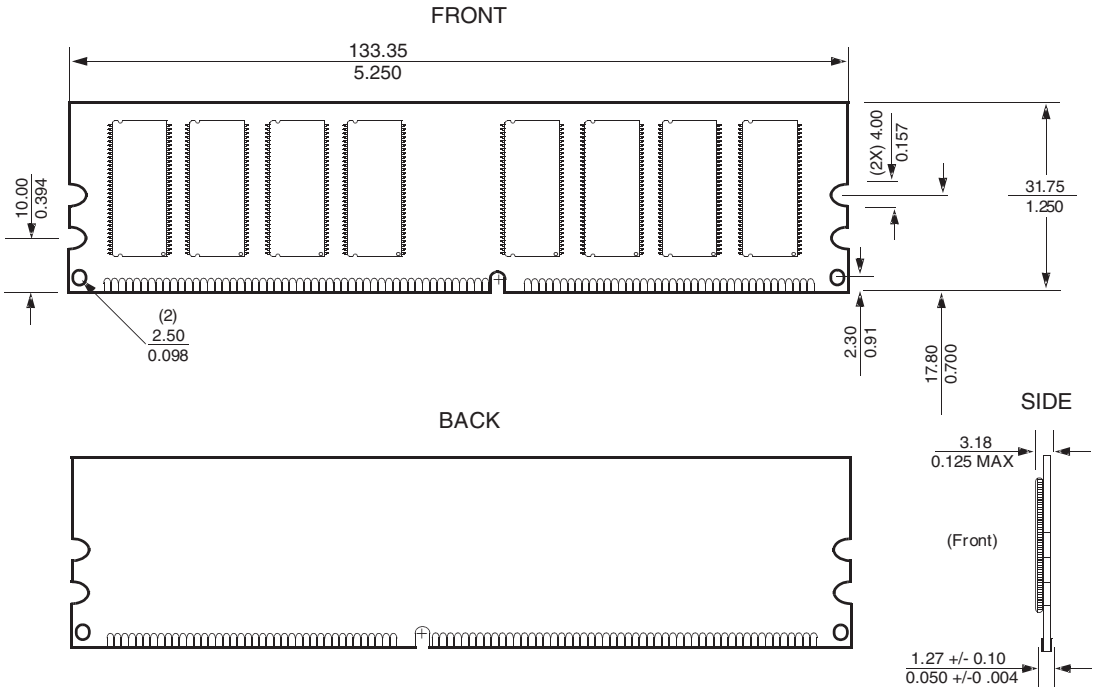
DESCRIPTION

ＳＭＤ－５１２４８は、５１２MビットＤＤＲ・ＤＲＡＭ（64M x 8bit）を８個搭載した６４Ｍｘ６４ビットＤＤＲ・ＤＲＡＭモジュールです。

FEATURES

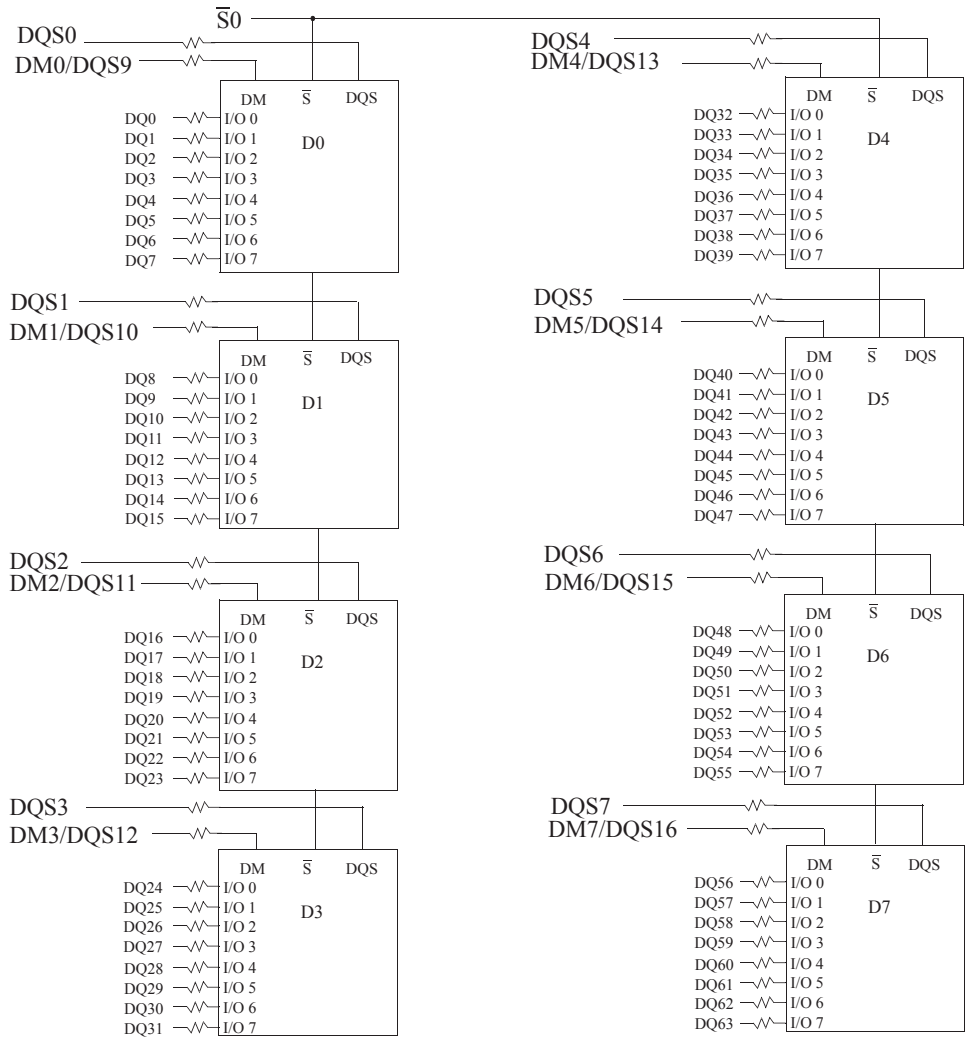
- **１８４ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール（ピン・ピッチ 1.27mm）**
- **基板高 １.２５”（３１．７５mm）**
- **ＣＬ－ｔＲＣＤ－ｔＲＰ=3－3－3（ＰＣ３２００）、2.5－3－3（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００）**
- **２．６Ｖ±０．１Ｖ単一電源（ＰＣ３２００）、２．５Ｖ±０．２Ｖ（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００）**
- **８，１９２リフレッシュ／６４ｍｓ**
- **ＳＳＴＬ＿２コンパチブル**
- **/ＣＡＳレイテンシー3.0，2.5，2.0クロックプログラマブル（ＰＣ３２００）**
- **〃 2.5，2.0クロックプログラマブル（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００）**
- **１バンク構成**
- **アンバッファードタイプ**
- **シリアルＰＤ**
- **接続端子：電解金メッキ（ｔ≧０．７６μm）**

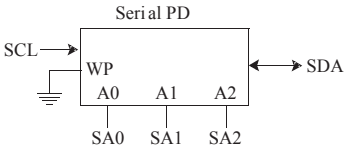
Outline Drawing



Note: All dimensions are typical unless otherwise stated millimeters / inches

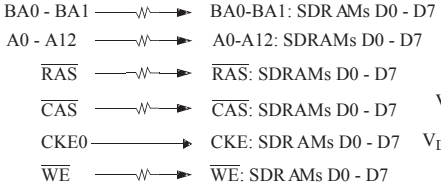
Functional Block Diagram

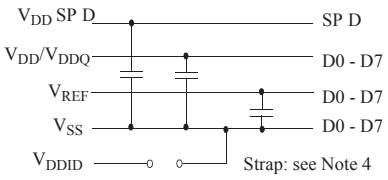




* Clock Wiring	
Clock Input	SDRAMs
*CK0/$\overline{CK0}$	2 SDAMs
*CK1/$\overline{CK1}$	3 SDAMs
*CK2/$\overline{CK2}$	3 SDAMs

* Wire per Clock Loading Table/ Wiring Diagrams





Notes:

1. DQ-to-I/O wiring is shown as recommended but may be changed.
2. DQ/DQS/DM/CKE /S relationship must be maintained as shown.
3. DQ, DQS, DM/DQS resisters: 22 ohms ± 5%
4. V_{DDID} strap connections
   (for memory device V_{DD}, V_{DDQ}):
   STRAP OUT (OPEN): $V_{DD} = V_{DDQ}$
   STRAP IN (V_{SS}): $V_{DD} \neq V_{DDQ}$.
5. BAx, Ax, $\overline{RAS}$, $\overline{CAS}$, $\overline{WE}$ resistors: 5.1 ohms ±5%
   (Except PC2100)